PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-126615

(43) Date of publication of application: 16.05.1995

(51)Int.Cl.

CO9K 11/06 H05B 33/14

(21)Application number: 05-273883

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

HODOGAYA CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

01.11.1993

(72)Inventor: SUZUKI MUTSUMI

FUKUYAMA MASAO MURAKAMI MUTSUAKI

NANBU TARO

TOMIYAMA HIROMITSU OSHINO MASAHIKO

(54) ELECTROLUMINESCENCE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an electroluminescence device capable of forming a thin film and excellent in luminescence stability and shelf life by using a specified tetraphenylbenzidine compound.

CONSTITUTION: This electroluminescence device is obtained by using a tetraphenylbenzidine compound of formula I (R1 and R3 are each H, a lower alkyl, a lower alkoxy, phenyl, etc.; R3 is H, methyl, methoxy, etc.), further preferably a triphenylamine trimer of formula II (R1 to R3 are each H. a lower alkyl, etc.; R4 is H, methyl, methoxy or chlorine) or benzidine dimer of formula III (X is p-phenylene, 1,4-diphenylmethane, etc.) as a material for a hole transfer layer.

(11)特許出願公開番号

特開平7-126615

(43)公開日 平成7年(1995)5月16日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

C 0 9 K 11/06

Z 9159-4H

庁内整理番号

H 0 5 B 33/14

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平5-273883

(22)出願日

平成5年(1993)11月1日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(71)出願人 000005315

保土谷化学工業株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2

(72) 発明者 鈴 木 睦 美

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号 松下技研株式会社内

(72) 発明者 福 山 正 雄

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号 松下技研株式会社内

(74)代理人 弁理士 蔵合 正博

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電界発光素子

(57)【要約】

【目的】 有機電界発光素子の発光安定性および保存安定性を改善する。

【構成】 正孔輸送層の材料として、新規なテトラフェニルベンジジン化合物、トリフェニルアミン3量体、またはベンジジン2量体を用いる。テトラフェニルベンジジン化合物は下記の一般式を有する。

(化1)

ただし、 R_1 、 R_2 は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、フェニル基、低級アルキル基または低級アルコキシ基を置換基として有するフェニル基、 R_3 は水素原子、メチル基、メトキシ基、またはクロル原子を

表す。また、R1、R2 の少なくとも一方は、ノルマルブチル基、イソプチル基、セカンダリプチル基、ターシャルプチル基、フェニル基、低級アルキル基または低級アルコキシ基を有するフェニル基を表す。別の正孔輸送層の材料として、上記3つの化合物から選定された少なくとも2種類を含む材料を用いることができる。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式で記述されるテトラフェニルベンジジン化合物を用いたことを特徴とする電界発光素子。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_3 & R_3 \\
\hline
 & R_2 & R_3 \\
\hline
 & R_2 & R_3
\end{array}$$

ただし、R₁、R₂ は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、フェニル基、低級アルキル基または低級アルコキシ基を置換基として有するフェニル基、R₅ は水素原子、メチル基、メトキシ基、またはクロル原子を表す。また、R₁、R₂ の少なくとも一方は、ノルマルプチル基、イソプチル基、セカンダリブチル基、ターシャルプチル基、フェニル基、低級アルキル基または低級*20

*アルコキシ基を有するフェニル基を表す。

【請求項2】 下記一般式で記述されるトリフェニルアミン3量体を用いたことを特徴とする電界発光素子。 【化2】

$$\begin{array}{c|c}
R_{2} & R_{4} & R_{4} \\
R_{3} & R_{4} & R_{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{4} & R_{4} & R_{2} \\
R_{4} & R_{4} & R_{2}
\end{array}$$

ただし、 R_1 、 R_2 、 R_3 は水素原子、低級アルキル基、または低級アルコキシ基、 R_4 は水素原子、メチル基、メトキシ基、またはクロル原子を表す。

【請求項3】 下記一般式で記述されるペンジジン2量 体を用いたことを特徴とする電界発光素子。

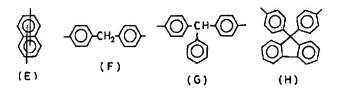
[化3]

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & & & \\
R_4 & N-X-N & R_4 \\
R_2 & & & \\
R_3 & & & \\
\end{array}$$

ただし、 R_1 、 R_2 、 R_3 は水素原子、低級アルキル基、または低級アルコキシ基、 R_4 は水素原子、メチル基、メトキシ基、またはクロル原子を表す。またXは以X

※下の構造を有する置換基を表す。

(化4]



このうちR₅ は水素原子、メチル基、メトキシ基、またはクロル原子を表す。

および電極を有することを特徴とする請求項1または2または3記載の電界発光素子。

【請求項4】 電極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層 50 【請求項5】 電極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層

3

および電極を有し、上記正孔輸送層として、請求項1記載のテトラフェニルペンジジン化合物、請求項2記載のトリフェニルアミン3量体、請求項3記載のペンジジン2量体の内から選定された少なくとも2種類を含む材料を用いたことを特徴とする電界発光素子。

【請求項6】 電子輸送層が発光層を兼ねていることを 特徴とする請求項4または5記載の電界発光素子。

【請求項7】 正孔輸送層が発光層を兼ねていることを 特徴とする請求項4または5記載の電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、少なくとも正孔輸送層、発光層および電子輸送層を有し、各種の表示装置として広範囲に利用される発光素子であって、低い印加電圧、高輝度、かつ安定性にも優れた有機電界発光素子(EL素子)に関する。

[0002]

【従来の技術】EL案子は自己発光のために液晶素子にくらべて明るく、鮮明な表示が可能であるため、古くから多くの研究者によって研究されてきた。現在実用レベ 20 ルに達した発光素子としては、無機蛍光体であるZnSを用いた素子がある。しかし、このような無機のEL素子は、発光のための印加電圧として200V以上が必要であるため、広く使用されるには至ってない。

【0003】これに対して有機材料を用いた発光素子は、従来実用的なレベルからは遠いものであったが、1987年にコダック社のC.W.Tangらによって開発された積層構造素子によりその特性が飛躍的に進歩した。彼らは蒸着膜の構造が安定で電子を輸送することのできる蛍光体と、正孔を輸送することのできる有機物と30を積層し、両方のキャリヤーを蛍光体中に注入して発光させることに成功した。これによって有機電界発光素子の発光効率が向上し、10V以下の電圧で1000cd/m²以上の発光が得られるようになった。その後多くの研究者によってその特性向上のための研究が行なわれ、現在では短時間の発光では10000cd/m²以上の発光特性が得られている。

【0004】このような有機発光素子の基本的な発光特性はすでに十分実用範囲にあり、現在その実用化を妨げている最も大きな原因は、第1にその駆動時の発光安定 40性の不足であり、第2に保存安定性の不足である。ここで言う駆動時の発光安定性の不足とは、素子電流を印加して駆動した時に発光輝度が低下し、ダークスポットと呼ばれる発光しない領域が発生したり、素子の短絡により破壊が起こる現象を言い、保存安定性の不足とは、製作した素子を保存しているだけでも発光特性が低下する現象を言う。

【0005】本発明者らはこのようなEL素子の発光の 安定性、保存安定性に関する問題点を解決するためその 劣化の機構を検討した。その結果、特性劣化の大きな原 50 因の一つがその正孔輸送層にあることが分かった。即ち、正孔輸送層として一般に利用される(化5:略称TPD)、(化6:略称TPAC)のような正孔輸送材料は、(1)湿度、温度、電流により結晶化して薄膜形状が一様でなくなる。(2)正孔輸送層が通電により分解する、などの変化を起こし、それによって発光性が著しく劣化することが分かった。

(化5]

10

【化6】

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、このような知見に基づき、発光安定性、保存安定性に優れた正孔輸送層を有する有機EL素子を提供することにある。このような正孔輸送材料の具備しなければならない条件としては、(1)優れた正孔輸送能力を持つこと、

- (2) 熱的に安定で、ガラス状態が安定であること、
- (3) 薄膜を形成できること、(4) 電気的、化学的に 安定であること、等を挙げることができる。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明者らは、ITO電極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層およびマグネシュウム/銀電極からなるEL素子を試作し、新たに合成した数多くの正孔輸送材料の評価を行なった。発光層としては主に電子輸送層を兼ねるアルミキノリン3量体を用いた。上記正孔輸送層の材料として、少なくとも(化7)で記述されるテトラフェニルペンジジン化合物、(化8)で記述されるトリフェニルアミン3量体、(化9)で記述されるペンジジン2量体を使用した。

[0008]

【化7】

【0009】ただし、R1、R2 は水素原子、低級アル キル基、低級アルコキシ基、フェニル基、低級アルキル 10 基または低級アルコキシ基を置換基として有するフェニ ル基、R。は水素原子、メチル基、メトキシ基、または クロル原子を表す。また、R1、R2の少なくとも一方 は、ノルマルプチル基、イソプチル基、セカンダリプチ ル基、ターシャルプチル基、フェニル基、低級アルキル 基または低級アルコキシ基を有するフェニル基を表す。

[0010]

【0011】ただし、R1、R2、R3は水素原子、低 級アルキル基、または低級アルコキシ基、R. は水素原 子、メチル基、メトキシ基、またはクロル原子を表す。 [0012]

【化9】

【0013】ただし、R1、R2、R3は水素原子、低 ※原子、メチル基、メトキシ基、またはクロル原子を表 級アルキル基、または低級アルコキシ基、R、は水素原 30 す。 子、メチル基、メトキシ基、またはクロル原子を表す。 [0014] またXは以下の構造を有する置換基を表し、R。は水素※ (化10]

[0015]

【作用】本発明は、上記のような正孔輸送材料を使用し た結果、それらが優れた正孔輸送能力を有しているばか りでなく、良好な薄膜を形成し、さらに熱的にも安定で あることが分かった。この結果、優れた発光安定性、保 50 フェニルベンジジン化合物は、相当する4,4'ージハ

存安定性を有するEL素子が実現できることが明らかに なり、表示素子として広範囲に利用することができた。 [0016]

【実施例1】本発明の正孔輸送材料の一つであるテトラ

ロゲン化ピフェニルと相当するジフェニルアミン化合物 との縮合反応、または相当するペンジジン化合物と相当 するハロゲン化アリールとの縮合反応により合成するこ とができる。これら縮合反応はウルマン反応として知ら れる方法である。

【0017】また、本発明の別の正孔輸送材料であるト リフェニルアミン3量体は、相当するアニリン化合物と 相当する4'-ハロゲン化ビフェニルアセトアニリド化 合物との縮合反応、そしてその加水分解により得られる より得られる。これら縮合反応はウルマン反応として知 られる方法である。

【0018】さらに、本発明の別の正孔輸送材料である ベンジジン2量体は、新規な化合物であり、これは、相 当するトリフェニルペンジジン化合物とジハロゲン化物 との縮合反応、または相当するジアミン化合物のN, N'ージアセチル体と相当する4'-ハロゲン化ピフェ ニルアセトアニリド化合物との縮合反応による生成物を 「加水分解した後、相当するハロゲン化アリールと縮合反 応はウルマン反応として知られる方法である。

【0019】これらの化合物の同定は、元素分析、IR 測定により行ない、さらに溶媒による再結晶法、真空昇 華法により精製し、純度を99.8%以上とした。純度 の確認はTLCスキャナー、TG-DTA、融点測定に より行なった。融点、分解点は正孔輸送層の熱安定性の 目安となり、ガラス転移点はガラス状態の安定性の目安 となる。発明者らは上記3種類の化合物の置換基を種々 に変えて材料を合成した。その結果、融点、分解点の大 は、融点、分解点が高い材料を得ることができた。以下 にいくつかの代表的な合成実施例を示す。

【0020】(合成実施例1)p-イソブチルアニリ ン、70.0g(0.47モル)を氷酢酸126mlに 溶解して、30° Cで無水酢酸59.9g(0.58モ ル)を滴下し、滴下終了後40°Cで1時間反応させ た。反応液を水300ml中へ注加し、析出した結晶を ろ過、水洗、乾燥した。この結晶をトルエン140m1 とn-ヘキサン、700mlの混合溶液で再結晶し、p -イソプチルアセトアニリド、60.4g(収率67. 3%) を得た。融点は124.5~125.0°Cであ

【0021】上記得られた、p-イソプチルアセトアニ リド、17.9g(0.094モル)とプロムペンゼン 22. 1g(0.14モル)、無水炭酸カリウム、1 6.9g(0.12モル)、銅粉、0.89g(0.0 14モル) を混合し、168~217°Cで14時間反 応させた。反応生成物をトルエン100m1で抽出し、 不溶分を濾別、除去後、濃縮乾固した。これをイソアミ ルアルコール、30mlで溶解し、水、3.4g、85 50 トルエン/n-ヘキサン=3/1)、N,N'-ビス

%水酸化カリウム、11.8g(0.18モル)を加 え、131°Cで加水分解した。水蒸気蒸留でイソアミ ルアルコール、過剰のプロムペンゼンを留去後、トルエ ン、120mlで抽出し、水洗、乾燥して濃縮した。濃 縮物は乾燥し、N-4-イソプチルフェニルアニリン、 17.6g(収率86.8%)を得た。

【0022】さらに、N-4-イソプチルフェニルアニ リン、17.6g(0.078モル)、4,4'ージョ ードビフェニル、12.6g(0.031モル)、無水 トリアミン化合物とハロゲン化アリールとの縮合反応に 10 炭酸カリウム、12.9g(0.093モル) および銅 粉、0.89g(0.014モル)を混合し、190~ 220°Cで12時間反応させた。反応生成物をトルエ ン、70mlで抽出し、不溶分を濾別、除去後、濃縮し てオイル状物とした。得られた粗製物は、カラムクロマ トにより精製して(担体:シリカゲル、溶離液:トルエ $\nu/n-\Lambda+t\nu=1/6$) 、N, N'- ℓ Z (p- ℓ ソプチルフェニル) - N, N' - ジフェニルペンジジ ン、8.5g(収率45.7%)を得た。融点は13 37. 8~135. 3° Cであった。元素分析、IR測定 応することにより合成することができる。これら縮合反 20 により生成物の同定を行なった。元素分析値は次の通り である。炭素:測定値87.77%、理論値:87.9 6%、水素:測定值7. 43%、理論值7. 38%、窒 素: 測定値4.51%、理論値4.66%。

【0023】(合成実施例2)アセトアニリド、23. 0g(0.17モル)と4,4'-ジョードピフェニ ル、85.3g(0.21モル)、無水炭酸カリウム、 24.9g(0.18モル)、銅粉、2.48g(0. 039モル)、ニトロペンゼン、40m1を混合し、1 90~205° Cで10時間反応させた。反応生成物を きさが置換基により変化し、いくつかの置換基の場合に 30 トルエン200mlで抽出し、不溶分を濾別、除去後、 濃縮乾固した。これをカラムクロマトにより精製して (担体:シリカゲル、溶離液:トルエン/n-ヘキサン =1/6) N-(4'-3-k-4-k7x=1)アセトアニリド、45.5g(収率64.8%)を得 た。融点は135、0~136、0°Cであった。

> 【0024】続いてN-(4'-ヨード-4-ピフェニ リル) アセトアニリド、18.2g(0.044モ ル)、アニリン、1.84g(0.020モル)、無水 炭酸カリウム、6.91g(0.050モル) および銅 粉、0.64g(0.010モル)、ニトロベンゼン、 10mlを混合し、190~215°Cで15時間反応 させた。反応生成物をトルエン100mlで抽出し、不 溶分を濾別、除去後、濃縮してオイル状物とした。オイ ル状物はイソアミルアルコール、50mlに溶解し、水 1ml、85%水酸化カリウム、2.64g(0.04 0 モル) を加え、130°Cで加水分解した。水蒸気蒸 留でイソアミルアルコールを留去後、トルエン250m 1で抽出し、水洗、乾燥して濃縮した。濃縮物はカラム クロマトにより精製して(担体:シリカゲル、溶離液:

9

(4'-フェニルアミノ-4-ピフェニリル)アニリン、8.85g(収率76.3%)を得た。

【0025】 さらにN, N'-ピス(4'-フェニルア 015モル)、ヨードベンゼン、6.74g(0.03 3 モル)、無水炭酸カリウム、4.56g(0.33モ ル) 、銅粉、0.48g(0.0075モル)、ニトロ ペンゼン、10mlを混合し、195~205°Cで1 6時間反応させた。反応生成物をトルエン100mlで 抽出し、不溶分を濾別、濃縮後、n-ヘキサンを加えて 粗結晶を取り出した。粗結晶はカラムクロマトにより精 製し、N, N'-ピス (4'-ジフェニルアミノ-4-ピフェニリル) アニリン、5.50g(収率:50.1 %)を得た。明瞭な融点は見られなかった。元素分析、 IR測定により生成物の同定を行なった。元素分析値は 以下の通りである。炭素: 測定値88.80%、理論 值:88.61%、水素:測定值5.77%、理論值 5. 65%、窒素: 測定値5. 62%、理論値5. 74

【0026】(合成実施例3)アセトアニリド、20.3g(0.15モル)と4,4'ージョードピフェニル、73.1g(0.18モル)、無水炭酸カリウム、22.1g(0.16モル)、銅粉、2.16g(0.034モル)、ニロトベンゼン、35mlを混合し、190~205°Cで10時間反応させた。反応生成物をトルエン200mlで抽出し、不溶分を濾別、除去後、濃縮乾固した。これをカラムクロマトにより精製して(担体:シリカゲル、溶離液:トルエン/酢酸エチル=6/1)、N-(4'ーヨード-4ーピフェニリル)アセトアニリド、40.2g(収率64.8%)を得た。融点は135.0~136.0°Cであった。

【0027】続いてN-(4'-ヨード-4-ピフェニ リル) アセトアニリド、13.2g(0.032モ ル)、ジフェニルアミン、6.60g(0.039モ ル)、無水炭酸カリウム、5.53g(0.040モ ル) および銅粉、0.45g(0.007モル)、ニト ロペンゼン、10mlを混合し、200~212°Cで 15時間反応させた。反応生成物をトルエン100ml で抽出し、不溶分を濾別、除去後、濃縮してオイル状物 とした。オイル状物はイソアミルアルコール、60m1 に溶解し、水1m1、85%水酸化カリウム、2.64 g(0.040モル)を加え、130°Cで加水分解し た。水蒸気蒸留でイソアミルアルコールを留去後、トル エン250mlで抽出し、水洗、乾燥して濃縮した。濃 縮物はカラムクロマトにより精製して(担体:シリカゲ ル、溶離液:トルエン/n-ヘキサン=1/2)、N, N, N'-トリフェニルペンジジン、10.5g(収率 72.2%) を得た。融点は167.5~168.5° Cであった。

【0028】さらにN, N, N'-トリフェニルベンジ 50 たが、もちろん本発明では発光層の材料として各種の希

ジン8. 66g (0. 021モル)、4,4'-ジョードピフェニル、4.06g (0.01モル)、無水炭酸カリウム、2.90g (0.021モル)、銅粉、0.32g (0.005モル)、ニトロベンゼン、10ml

10

を混合し、195~210° Cで20時間反応させた。 反応生成物をトルエン140mlで抽出し、不溶分を濾 別、濃縮後、n-ヘキサン120mlを加えて粗結晶を 取り出した。粗結晶はカラムクロマトにより精製し(担

体:シリカゲル、溶離液:トルエン/n-ヘキサン=1 /2)、N,N'-ピス(4'-ジフェニルアミノ-4

-ピフェニリル) -N, N' -ジフェニルベンジジン、4.73g(収率:48.5%)を得た。融点は242.5~243.5°Cであった。元素分析、IR測定

67%、水素:測定值5.70%、理論值5.58%、 窒素:測定值5.68%、理論值5.75%。

[0029]

【実施例2】次に、これらを実際にEL素子として評価 20 し、その素子の発光特性、発光特性の安定性、保存安定 性を検討した。EL素子は、図1に示すように、ガラス 基板1上に透明電極2としてITO電極をあらかじめ形 成したものの上に、正孔輸送層3、電子輸送層兼発光層 4、Mg/Ag電極5の順に蒸着して作成した。まず、 十分に洗浄したガラス基板(IT〇電極は生膜済み)、 正孔輸送材、電子輸送性発光材として精製したアルミキ ノリン3量体を蒸着装置にセットした。0.1nm/秒 の速度で正孔輸送層を蒸着し、膜厚を変えた試料を作成 して最適の発光が得られる厚さを決定した。膜厚は材料 30 によって異なるが、最適膜厚は40~60nmの間の厚 さであった。なお膜厚は水晶振動子によってモニターし た。アルミキノリン3量体の蒸着は同じく0.1nm/ 秒の速度で行ない、その膜厚は50nmとした。Mg/ Ag電極は0.4nm/秒の速度で行ない、その厚さを 100 nmとした。これらの蒸着はいずれも真空を破ら ずに連続して行なった。素子作製後、直ちに乾燥窒素中 で電極の取り出しを行ない、引続き特性測定を行なっ た。

【0030】得られた素子の発光特性は100mA/c m²の電流を印加した場合の発光輝度で定義した。また、発光の安定性は200cd/m²の発光が得られる電流を連続で印加し、その時の発光輝度の変化を測定した。発光の寿命は輝度が半分の100cd/m²になるまでの時間と定義した。保存安定性は室温、乾燥空気中に一定時間素子を放置後、20mA/c m²の電流を印加し、輝度が初期発光特性の半分になるまでの時間で定義した。

【0031】本発明の正孔輸送材料の評価のために、電子輸送層兼発光層4としてアルミキノリン3量体を用いたが、もちろん本発明では発光層の材料として各種の希

土類錯体、オキサゾール誘導体、ポリパラフェニレンビ ニレンなどの各種の材料を用いることができる。また、 発光層にキナクリドンやクマリンなどのドーパントを添 加することにより、さらに高性能のELを作製すること ができる。さらにまた、電子輸送層、発光層、正孔輸送 層の3層からなる電界発光素子とすることもできる。ま た、本発明の正孔輸送材料と適性な電子輸送材料とを組 み合わせることにより、正孔輸送層を発光層として用い ることもできる。

【0032】このような検討の結果、正孔輸送材料が1 30°C以上の融点、300°C以上の分解点を有する 場合には優れた発光の安定性、保存安定性が得られるこ とが分かった。したがって、上記化合物の置換基は、本 発明の置換基に限らず、上記以上の融点、分解点を持つ ものであれば使用できる。

【0033】また、本発明による正孔輸送材料は、単独 で用いることもできるが、2種類以上を共蒸着などで生 膜して混合状態で用いることができる。さらに、本発明 の正孔輸送材料を従来の正孔輸送材料であるTPACや 類以上を同時蒸着して用いることにより、その結晶化を 起こし難くする効果をしばしば呈する。

【0034】 (素子実施例1) 十分に洗浄した ITO電 極、正孔輸送材としてテトラフェニルペンジジン化合物 (1) $(R_1 = p - n - Bu, R_2 = H, R_3 = H, m)$ p=132.9°C)、電子輸送性発光材として精製し たアルミキノリン3量体を蒸着装置にセットした。0. 1 nm/秒の速度で化合物(1)を50 nmの厚さで蒸 着した。なお膜厚は水晶振動子によってモニターした。 行ない、その膜厚は50nmとした。Mg/Ag電極は 0. 4 nm/秒の速度で行ない、その厚さを100 nm とした。これらの蒸着はいずれも真空を破らずに連続し て行なった。素子作製後、直ちに乾燥窒素中で電極の取 り出しを行ない、引続き特性測定を行なった。発光特性 は2500cd/m²、発光の寿命は620Hr、保存 安定性は2200Hrであった。

【0035】比較のために正孔輸送材として(化5:略 称TPD)、(化6:略称TPAC)を用いて同じ条件 光特性、発光の寿命性、保存安定性はそれぞれ、220 0 c d/m² 、220Hr、460Hrであった。-方、TPACでの発光性、発光の寿命性、保存安定性は それぞれ、2500cd/m²、280Hr、560H rであった。このことから本実施例におけるテトラフェ ニルペンジジン化合物(1)は、発光寿命、保存安定性 に優れていることが分かった。

【0036】 (素子実施例2) 素子実施例1と同様の方 法でそれぞれ、テトラフェニルベンジジン化合物(2) $(R_1 = i B u, R_2 = H, R_3 = H), (3) (R_1)$

12

 $= i B u, R_2 = H, R_3 = C H_3), (4) (R_1 =$ $t B u, R_2 = H, R_3 = H), (5) (R_1 = t B)$ $u, R_2 = t B u, R_3 = H), (6) (R_1 = C_6 H)$ $_{5}$, R_{2} = H, R_{3} = H) , (7) (R_{1} = C_{6} H₅ , $R_2 = C_6 H_6 , R_3 = H) , (8) (R_1 = C$ $_{6}$ H_{5} , R_{2} = C_{6} H_{5} , R_{3} = CH_{3}) , (9) (R $_{1} = p - CH_{3} - C_{6} H_{4}$, $R_{2} = H$, $R_{3} = OC$ H_3), (10) $(R_1 = p - CH_3 - C_6 H_6, R_2)$ = p - C H_s - C₆ H₄ 、R_s = H) を正孔輸送材とし て使用したEL素子を作製し、その特性を評価した。そ の結果を図2に示す。なお、上記テトラフェニルペンジ ジン化合物 (2) ~ (10) のR1 およびR2 の置換位 置はすべてpー位を示す。このことから本発明によるテ トラフェニルベンジジン化合物 (2)~(10)は、発 光寿命、保存安定性に優れていることが分かった。

【0037】 (素子実施例3) 素子実施例1と同様の方 法でそれぞれ、トリフェニルアミン3量体化合物(1 1) $(R_1 = H, R_2 = H, R_3 = H, R_4 = H)$ (12) $(R_1 = H, R_2 = H, R_3 = H, R_4 = CH)$ TPDとの共蒸着によって使用することができる。2種 20 g)、(13)(R₁ = tBu、R₂ = p-CH₈、R $_{3} = p - CH_{3}$, $R_{4} = H$), (14) ($R_{1} = H$, R $_{2}$ =H, R_{3} =H, R_{4} =OCH₃), (15) (R_{1} $=H, R_2 = m-CH_3, R_3 = m-CH_3, R_4 =$ H), (16) $(R_1 = H, R_2 = p - OCH_3, R_3)$ $= p - OCH_3$, $R_4 = H$), (17) $(R_1 = p - C$ H_3 , $R_2 = H$, $R_3 = H$, $R_4 = CH_3$) , (18) $(R_1 = p - CH_3, R_2 = p - i Bu, R_3 = p - i$ $Bu, R_1 = H), (19) (R_1 = p - nBu, R_2)$ $=m-CH_3$, $R_3=H$, $R_4=C1$) (20) (R_1 アルキミノリンの蒸着は同じく0. 1 n m / 秒の速度で 30 = p − O C₂ H₅ 、R₂ = p − C H₅ 、R₃ = p − C H s、R₄ = H)を正孔輸送材として使用したEL素子を 作製し、その特性を評価した。その結果を図3に示す。 このことから本発明によるトリフェニルアミン3量体化 合物(11)~(20)は、発光寿命、保存安定性に優 れていることが分かった。

【0038】 (素子実施例4) 素子実施例1と同様の方 法でそれぞれ、ペンジジン2量体化合物(21)(R1 $=H, R_2 = H, R_3 = H, R_4 = H, X = (A)$ (22) $(R_1 = H, R_2 = H, R_3 = H, R_4 = H,$ でEL素子を作製し、その特性を調べた。TPDでの発 40 X=(B))、(23)(R₁=H、R₂=H、R₃= $H, R_4 = H, R_5 = H, X = (C)$, (24) (R $_{1}$ =H, R_{2} =H, R_{3} =H, R_{4} =CH₃, R_{5} =C H_8 , X = (C)), (25) $(R_1 = H, R_2 = H,$ $R_3 = H, R_4 = H, X = (D)$), (26) $(R_1 =$ H, $R_2 = H$, $R_3 = H$, $R_4 = CH_3$, X =(D)), (27) $(R_1 = H, R_2 = m - OCH_3,$ R₃ =m-OCH₃、R₄ =OCH₃、X=(E:結合 位置は1,4-である))、(28)(R1 = H、R2 = p - t B u, $R_1 = H$, $R_4 = C l$, X = (F)), (29) $(R_1 = p - OC_2 H_6, R_2 = H, R_3 =$

1.3

H, $R_4 = H$, X = (G)) (30) ($R_1 = H$, R_2 = p - n P r, $R_{3} = p - n P r$, $R_{4} = H$, X =(H)) を正孔輸送材として使用したEL素子を作製 し、その特性を評価した。その結果を図4に示す。この ことから本発明によるペンジジン2量体化合物(21) ~ (30)は、発光寿命、保存安定性に優れていること が分かった。

【0039】 (素子実施例5) 素子実施例1と同様の方 法でそれぞれ、トリフェニルアミン3量体化合物(1 トラフェニルペンジジン化合物 (4) $(R_1 = p - t B)$ u、R₂ =H、R₃ =H) を共蒸着し、正孔輸送材とし て使用したEL素子を作製し、その特性を評価した。発 光特性は3300cd/m²、発光の寿命は720H r、保存安定性は2900Hrであった。その結果から 本発明によるトリフェニルアミン3量体化合物(11) とテトラフェニルベンジジン化合物 (4) の共蒸着によ って形成された正孔輸送層は、発光寿命、保存安定性に 優れていることが分かった。

法で正孔輸送材としてペンジジン2量体化合物(23) $(R_1 = H, R_2 = H, R_3 = H, R_4 = H, R_5 =$ H、X=(C))、電子輸送材として精製したトリアゾ ールを使用したEL素子を作製し、その特性を評価し た。なお、この場合はトリアゾールの正孔プロッキング 性が高いために正孔輸送材からの青色発光が確認され た。 発光特性は 200 c d/m²、 発光の寿命は 300 Hr、保存安定性は2700Hrであった。比較のため に正孔輸送材として (化5:略称TPD) を用いて同じ 条件でEL素子を作製しその特性を調べた。TPDでの 30 5 Mg/Ag電極 発光特性、発光の寿命特性、保存安定性は、それぞれ1

14

00cd/m²、110Hr、410Hrであった。こ のことから本発明によるペンジジン2量体化合物(2 3) は発光寿命、保存安定性に優れていることが分かっ た。

[0041]

【発明の効果】以上のように、本発明は、正孔輸送層の 材料として、テトラフェニルペンジジン化合物、トリフ ェニルアミン3量体、ペンジジン2量体を用いたことを 特徴とする電界発光素子であり、本発明の材料を用いる 1) (R₁ = H、R₂ = H、R₃ = H、R₄ = H) とテ 10 ことにより、従来の有機電界発光素子の最も大きな問題 点であった発光安定性および保存安定性を格段に改良し た電界発光素子を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における電界発光素子の構成 を示す部分断面拡大斜視図

【図2】本発明の一実施例における正孔輸送層としてテ トラフェニルペンジジン化合物を用いた電界発光素子の 特性を示す一覧図

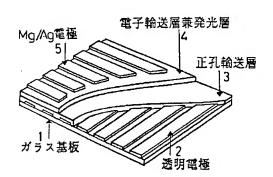
【図3】本発明の一実施例における正孔輸送層としてト 【0040】 (素子実施例6)素子実施例1と同様の方 20 リフェニルアミン3量体化合物を用いた電界発光素子の 特性を示す一覧図

> 【図4】本発明の一実施例における正孔輸送層としてペ ンジジン2量体量体化合物を用いた電界発光素子の特性 を示す一覧図

【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 透明電極
- 3 正孔輸送層
- 4 電子輸送層兼発光層

[図1]



【図2】

化合物Nn	克光粉性 (cd/m2)	発光寿命 (31)	位在安定性 (Br)
2	8200	5 6 0	1 4 0 0
3	2500	670	1 6 0 0
4	4100	6 5 0	1100
5	2 5 0 0	700	2100
G	3 7 0 0	4 5 0	1 8 0 C
7	2900	B 0 0	2 2 0 0
8	3 2 0 0	4 5 0	1 9 0 0
9	4000	5 9 0	1700
	3600	670	z 2·0 0

【図3】

(t∆tn×o	免形物性 (cd/m2)	為克斯亞 (Br)	以存安定者 (317)
1 1	4200	7 2 0	2900
1 2	2800	770	2600
13	2 4 0 0	6 9 0	1800
1.4	8 1 6 0	6 6 0	3 2 0 D
1 8	1700	8 9 0	2000
1 6	8 2 0 0	9 2 0	1800
1.7	2800	8 7 0	2 4 0 0
1 8	2700	5 5 0	2000
19	3000	088	1700
2 0	2900	9 5 0	2 2 0 0

【図4】

化合物料の	炎光特性 (cd/m2)	免沈劳介 (Er)	(III)
2 1	3400	760	3 9 0 0
2 2	2800	490	2 2 0 0
2 3	2700	6 5 0	2000
2 4	3000	4 5 0	2 4 0 0
2 5	3000	6 2 0	1 8 0 0
2 6	1900	750	1 2 0 0
2 7	2700	4,9 0	3 9 0 0
2 B	2800	4 8 C	2 2 0 0
2 9	2 8 0 0	410	2100
9.0	3300	5 8 0	2200

フロントページの続き

(72)発明者 村 上 睦 明 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1 号 松下技研株式会社内 (72)発明者 南 部 太 郎 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1 号 松下技研株式会社内

(72)発明者 富 山 裕 光 茨城県つくば市御幸ケ丘45番地 保土谷化 学工業株式会社筑波研究所内 (72)発明者 押 野 雅 彦 茨城県つくば市御幸ケ丘45番地 保土谷化 学工業株式会社筑波研究所内